

	<p>Hersteller-Teilenummer: SISS02DN-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHAN 25V POWERPAK 1212-</p>
	<p>Datenblätter:  SISS02DN-T1-GE3.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SISS02DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 25V POWERPAK 1212-
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	+16V, -12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8S
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 65.7W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8S
Andere Namen	SISS02DN-GE3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4450pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	83nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 25V 51A (Ta), 80A (Tc) 5W (Ta), 65.7W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	51A (Ta), 80A (Tc)

SISS02DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SISS02DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SISS02DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SISS02DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SISM672A1BD SIS SIS BGAPB</p>	 <p>SISS10DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK 1212-8S</p>	 <p>SISS10DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A PPAK 1212-8S</p>	 <p>SISJ xx xx XX</p>
 <p>SISS04DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 30V POWERPAK 1212-</p>	 <p>SISS12DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 40V POWERPAK 1212-</p>	 <p>SISM xx xx XX</p>	 <p>SISNAP915DK Silicon Labs RF EVAL 915MHZ SYNAPSE DEV KIT</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SISS02DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SISS02DN-T1-GE3 Datenblatt	SISS02DN-T1-GE3-Datenblätter	SISS02DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SISS02DN-T1-GE3
SISS02DN-T1-GE3 Electronic	SISS02DN-T1-GE3-Komponenten	SISS02DN-T1-GE3-Verteiler	SISS02DN-T1-GE3-Bild	SISS02DN-T1-GE3-Teil
SISS02DN-T1-GE3 Preis	SISS02DN-T1-GE3 Hersteller	SISS02DN-T1-GE3 Bild	SISS02DN-T1-GE3 Aktie	SISS02DN-T1-GE3 Inventar
SISS02DN-T1-GE3 Neu	SISS02DN-T1-GE3 Original	SISS02DN-T1-GE3 garantiert	SISS02DN-T1-GE3 RFQ	SISS02DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited